

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4060876号
(P4060876)

(45) 発行日 平成20年3月12日(2008.3.12)

(24) 登録日 平成19年12月28日(2007.12.28)

(51) Int.Cl.

F I

H05B 33/22 (2006.01)

H05B 33/22 Z

H05B 33/12 (2006.01)

H05B 33/12 B

H01L 51/50 (2006.01)

H05B 33/14 A

G09F 9/30 (2006.01)

G09F 9/30 365Z

H01L 27/32 (2006.01)

請求項の数 10 (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願2006-278761 (P2006-278761)
(22) 出願日 平成18年10月12日(2006.10.12)
(62) 分割の表示 特願2006-102240 (P2006-102240)
の分割
原出願日 平成7年11月10日(1995.11.10)
(65) 公開番号 特開2007-42658 (P2007-42658A)
(43) 公開日 平成19年2月15日(2007.2.15)
審査請求日 平成18年10月12日(2006.10.12)
(31) 優先権主張番号 特願平7-53011
(32) 優先日 平成7年3月13日(1995.3.13)
(33) 優先権主張国 日本国(JP)

(73) 特許権者 000005016
パイオニア株式会社
東京都目黒区目黒1丁目4番1号
(74) 代理人 100079119
弁理士 藤村 元彦
(72) 発明者 永山 健一
埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番2号 パ
イオニア株式会社 総合研究所内
(72) 発明者 宮口 敏
埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番2号 パ
イオニア株式会社 総合研究所内

審査官 福田 聡

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の発光部からなる画像表示配列を有している有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネルであって、

基板上に形成された第1表示電極と、

前記第1表示電極上に形成され、前記複数の発光部に対応する開口部を有する絶縁膜と、

前記絶縁膜上に形成された、前記基板に平行な方向に突出するオーバーハング部を上部に有する隔壁と、

前記開口部を覆って形成された有機エレクトロルミネッセンス媒体の薄膜と、

前記隔壁の両側において縁部が前記有機エレクトロルミネッセンス媒体の薄膜を介して前記絶縁膜に重なるように形成され、るとともに前記隔壁の上面と根本で分断された第2表示電極と、を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。

。

【請求項2】

前記隔壁が逆テーパ形状を有することを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。

【請求項3】

前記隔壁は前記絶縁膜を貫通し、前記第1表示電極に接していることを特徴とする請求項1又は2記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。

10

20

【請求項 4】

前記第 1 表示電極及び第 2 表示電極は、複数のストライプ状の電極でありかつ互いに直交する位置に配列されたことを特徴とする請求項 1 から 3 記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。

【請求項 5】

前記基板及び前記第 1 表示電極が透明であることを特徴とする請求項 1 から 4 記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。

【請求項 6】

前記第 2 表示電極上に形成された反射膜を有することを特徴とする請求項 1 から 5 記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。

10

【請求項 7】

前記第 2 表示電極が透明であることを特徴とする請求項 1 から 6 記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。

【請求項 8】

前記第 1 表示電極の外側に形成された反射膜を有することを特徴とする請求項 1 から 7 記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。

【請求項 9】

前記絶縁膜上に達し、前記第 2 表示電極を完全に覆う封止膜をさらに有することを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。

【請求項 10】

20

前記封止膜は、前記絶縁膜、前記有機エレクトロルミネッセンス媒体の薄膜、前記第 2 表示電極及び前記隔壁を完全に覆うことを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、電流の注入によって発光する有機化合物材料のエレクトロルミネッセンス（以下、EL という）を利用して、かかる有機 EL 材料の薄膜からなる発光層を備えた有機 EL 素子の複数をマトリクス状に配置した有機 EL ディスプレイパネルに関する。

【背景技術】

30

【0002】

一般に、有機 EL 素子の陰極や有機 EL 媒体層をマイクロパターニングすることは、電荷注入層や発光層に用いられる有機 EL 媒体の耐熱性（一般に 100℃以下）、耐溶剤性、耐湿性の低さのため困難である。例えば、通常薄膜のパターニングに用いられるフォトリソグラフィ法を有機 EL 素子に用いると、フォトレジスト中の溶剤の素子への侵入や、フォトレジストベーク中の高温雰囲気や、フォトレジスト現像液またはエッチング液の素子への侵入や、ドライエッチング時のプラズマによるダメージ等の原因により有機 EL 素子特性が劣化する問題が生じる。

【0003】

また、蒸着マスクを用いてパターニングする方法もあるが、基板及び蒸着間のマスクの密着不良による蒸着物の回り込みや、強制的に基板と蒸着マスクを密着させた場合のマスクとの接触により有機 EL 媒体層が傷ついてインジウム錫酸化物（以下、ITO という）などからなる陽極と陰極がショートすることや、陰極のストライプ状パターンなど開口部が大きくマスク部が細かいパターンの場合にはマスク強度が不足しマスクが撓むこと等の問題により、微細なパターンが形成できない。

40

【0004】

現在、有機 EL 材料を用いたディスプレイパネルとしては、例えば、特許文献 1 乃至 4 に開示されているものがある。このフルカラーディスプレイは、交差している行と列において配置された複数の発光画素からなる画像表示配列を有している発光装置である。

【0005】

50

この発光装置においては、各々の画素が共通の電気絶縁性の光透過性基板上に配置されている。各行内の画素は、基板上に伸長して配置された共通の光透過性第1電極を含有し且つ該電極によって接合されている。隣接行内の第1電極は、基板上で横方向に間隔をあけて配置されている。有機EL媒体は、第1電極及び基板によって形成された支持面の上に配置されている。各列の画素は、有機EL媒体上に配置された共通に伸長した第2電極を含有し且つ該電極によって接続されている。隣接列内の第2電極は、有機EL媒体上で横方向に間隔をあけて配置されている。この発光装置においては有機EL媒体を挟んで交差している第1及び第2電極のラインを用いた単純マトリクス型を採用している。

【0006】

前述の問題を解決する方法が、上記文献に開示されている。たとえば、特許文献1に開示の技術は、有機EL媒体を溶解しない溶剤を用いたフォトレジストを素子上にパターンニングし、希硫酸を用いて陰極をエッチングする方法である。しかし、エッチングの際、希硫酸により有機EL媒体が損傷を受ける。

【0007】

また、特許文献2、3及び4に開示の技術は、ITOパターンニング後の基板上に平行に配置したストライプ状の数〜数十 μm の高さの隔壁を作製し、その基板に隔壁に対して垂直方向、基板面に対して斜めの方向から有機EL媒体や陰極材料を蒸着することによりパターンニングする方法である。即ち、第1電極ライン及び有機EL媒体の薄膜を、予め基板に設けられている境界の高い壁により所定気体流れを遮って、選択的に斜め真空蒸着して形成する製造方法が採用されている。しかし、この方法は、斜めの蒸着方向に対し垂直な方向にしかパターンニングできず、ストライプ状の形状にしかない。このため、RGBがデルタ配置されたものや、陰極が屈曲もしくは蛇行するようなディスプレイパネルは実現できない。

【特許文献1】特開平2-66873号公報（第5頁、図1）

【特許文献2】特開平5-275172号公報（第5頁、図2）

【特許文献3】特開平5-258859号公報（第8頁、図2）

【特許文献4】特開平5-258860号公報（第4頁、図2）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

この従来技術は基板に垂直な高い壁を設けてその高い壁を蒸着マスクとして使用するというものだが、特にパターンが微細になった場合、断面のアスペクト比（底辺／高さ）の非常に大きな高い壁をフォトレジスト等で形成するのは困難であり、また、その形成後の第1及び第2電極ライン及び有機EL媒体膜の信頼性に不安定要素が大きい。また、斜め真空蒸着の精度、工程の複雑さ等の問題点がある。

【0009】

本発明は、このような問題を解決すべくなされ、本発明の目的は、有機EL媒体層や陰極が素子の特性を劣化することなく自由な形状にパターンニングできるディスプレイを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネルは、複数の発光部からなる画像表示配列を有している有機エレクトロルミネッセンスディスプレイパネルであって、基板上に形成された第1表示電極と、第1表示電極上に形成され、複数の発光部に対応する開口部を有する絶縁膜と、絶縁膜上に形成された隔壁と、上記開口部を覆って形成された有機エレクトロルミネッセンス媒体の薄膜と、上記有機エレクトロルミネッセンス媒体の薄膜上であって、隔壁の両側において縁部が上記絶縁膜上に形成された第2表示電極と、を有することを特徴としている。

【発明の効果】

【0011】

本発明によれば、以下の効果が得られる。

【0012】

(1) 有機EL膜を成膜後はパターニング等有機EL媒体に損傷を与える工程を行う必要がない。隔壁により、有機EL媒体層へ傷付けを防止でき有機機能層の保護が達成できる。

【0013】

(2) 従来の有機ELディスプレイパネル製造方法より工程が少なく、RGB有機層の分離が確実に行なえ、精度良くRGBの媒体の塗り分けができる。

【0014】

(3) 自由な形状に電極をパターニングできる。

10

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

以下に、本発明による実施例を図面を参照しつつ説明する。

【0016】

図1に示すように、実施例の有機ELディスプレイパネルはマトリクス状に配置されかつ各々が赤R、緑G及び青Bの発光部からなる発光画素1の複数からなる画像表示配列を有している。また、RGBの発光部に代えてすべてを単色の発光部としてモノクロムディスプレイパネルを形成できる。

【0017】

図2に示すように、この有機ELディスプレイパネルの基板2上には、ITOなどからなる第1表示電極ライン3が設けられている。第1表示電極ライン3は互いに平行な複数のストライプ状に配列されている。

20

【0018】

さらに基板2上から突出する複数の電気絶縁性の隔壁7が、図2及び図3に示すように、第1表示電極ライン3に直交するように基板2及び第1表示電極ライン3上にわたって形成されている。すなわち、隔壁7が少なくとも第1表示電極ライン3の一部分を露出せしめるように、形成されている。

【0019】

隔壁7の上部に基板に平行な方向に突出するオーバーハング部7aが、隔壁7の伸長方向に沿って形成されている。

30

【0020】

露出している第1表示電極ライン3の部分の各々上に、少なくとも1層の有機EL媒体8の薄膜が形成されている。たとえば、有機EL媒体8は、有機発光層の単一層、あるいは有機正孔輸送層、有機発光層及び有機電子輸送層の3層構造の媒体、または有機正孔輸送層及び有機発光層2層構造の媒体などである。

【0021】

有機EL媒体8の薄膜上にその伸長方向に沿って第2表示電極ライン9が形成されている。この様に、第1及び第2表示電極ラインが交差して挟まれた有機EL媒体の部分が発光部に対応する。

【0022】

40

この単純マトリクス型のパネルの第2表示電極9の上には保護膜10または保護基板が設けられることが好ましい。また、上記実施例の有機ELディスプレイパネルにおいて、基板及び第1表示電極が透明であり、発光は基板側から放射されるので、図3に示すように、発光効率を高めるために第2表示電極上または保護膜を介して反射膜21を設けることが好ましい。逆に、他の実施例の有機ELディスプレイパネルにおいて、第2表示電極を透明材料で構成して、発光を第2表示電極側から放射させることもできる。この場合、発光効率を高めるために第1表示電極の外側に反射膜を設けることが好ましい。

【0023】

次に、有機ELディスプレイパネル製造工程を説明する。

【0024】

50

図4に示すように、パターニング工程により、第1表示電極3としてITO等からなる導電性透明膜（例えば、0.3mmピッチ、0.28mm幅、0.2μm膜厚）が複数本平行に成膜されているガラス等の透明基板2を用意する。

【0025】

次に、隔壁形成工程では、隔壁材料の非感光性のポリイミド70を、例えばスピコート法で3μm膜厚に透明基板2の第1表示電極3上に形成し、さらに隔壁の上部のオーバーハング部の材料のSiO₂71を、ポリイミド膜70上に例えばスパッタ法で0.5μm膜厚に形成する。

【0026】

次に、図5(a)に示すように、SiO₂膜71上に、フォトレジストをスピコートで例えば1μm膜厚に成膜して、例えば20μmの幅のフォトレジストリッジ72を残すように通常のフォトリソグラフィ法等の手法を用いてフォトレジストパターンを形成する。

10

【0027】

続いて図5(b)に示すように、該フォトレジストリッジ72をマスクとして、リアクティブイオンエッチング等を手法を用いてSiO₂膜71をフォトレジストと同一のパターン形状にエッチングする。このリアクティブイオンエッチングを行う時は、例えばエッチングガスはCF₄を用いてガス流量100sccm、RFパワー100Wで10分間でエッチングが完了する。

【0028】

20

その後、図5(c)に示すように、ドライエッチング又はウェットエッチングを用いて、ポリイミド膜70の隔壁本体及びその上部に基板に平行な方向に突出するオーバーハング部7aのSiO₂膜71からなる断面が略T字型の隔壁7を形成する。T字型の隔壁7の基板からの高さは、後に形成される第2表示電極の陰極9とITO陽極3が電氣的に短絡されない様な高さであればいくらかでもよい。具体的には1μm以上10μm以下が望ましい。またT字の横方向のオーバーハング部7aも同様の理由で、片側約1μm幅で0.2μm以上程度の膜厚があれば十分である。

【0029】

このT字型隔壁7は、図6(a)に示すように、初めにO₂などのガスを用いてリアクティブイオンエッチング（異方性エッチング）を行い、ポリイミド膜70をアンダーカットがないように垂直にドライエッチングし、その後図6(b)に示すように、アルカリ溶液で30秒間程度ウェットエッチングを行いポリイミド膜70の側面70aを等方的にエッチングすることで形成できる。この2段階エッチングプロセスでは、均一なサイドエッチングが行える。図7(a)はこの2段階工程で作成したT字型隔壁7の断面図である。

30

【0030】

ポリイミド膜70をエッチングする他の方法としては、異方性エッチングを予め行わず、ポリイミドのエッチャントであるアルカリ溶液で1～2分間、等方的にエッチングを行うことでSiO₂膜71をマスクとしてポリイミド膜70がエッチングできる。この時ウェットエッチングでポリイミドをエッチングするので、等方性エッチングとなり、図7(b)に示すように、アンダーカットの状態となる。

40

【0031】

尚、これまでポリイミドと称していたのは、イミド化する前の前駆体状態の物質であり図3の状態の段階で300℃で硬化せしめると本当のポリイミドとなるのはもちろんである。しかし、強度その他不都合がなければ、その物質を硬化させなくても構わない。また、ポリイミド及びSiO₂の代わりの材質としては、下部の隔壁材料と上部のオーバーハング部の材料がそれぞれエッチングされる際に、これら自体がエッチングされない絶縁物であれば何でもよく、有機EL媒体の成膜前に強度を保持できる電気絶縁性物質を用いることが出来る。

【0032】

また、このような2層構造隔壁の代わりに、図7(c)～(h)に示すように、フォト

50

レジストをクロルベンゼン処理する等の方法でT字形状断面あるいは、逆テーパ断面（図7（c），（d））を有する隔壁など上部のオーバーハング部を有する隔壁を形成しても構わない。

【0033】

その後、図8（a）～（d）に示すように、発光層形成工程にて、露出した第1表示電極3の部分の各々上に有機EL媒体を堆積させ、少くとも1層の有機EL媒体の薄膜を形成し、つぎの第2表示電極形成工程にて、有機EL媒体の薄膜の複数の上に第2表示電極を形成する。図ではRGB3色の2画素のみの説明であるが、実際は2次元に複数の画素を同時に形成する。

【0034】

まず、発光層形成工程では図8（a）に示すように、隔壁7が形成された基板2の凹部の各1つに成膜用マスク30の各1つの穴部31を位置合わせした後、隔壁上にマスクを載置して、1番目（例えば赤色）の有機EL媒体8aを例えば蒸着などの方法を用いて所定厚さに成膜する。基板は有機EL媒体の蒸気流に対して自由な角度で行っても良いが、蒸気流が隔壁のオーバーハング部を回り込む様にすることが好ましい。

【0035】

図8（b）の工程では、例えば成膜用マスクを左に隔壁1個分ずらして位置合わせをした後、隔壁上にマスクを載置して2番目（例えば緑色）の有機EL媒体8bを所定膜厚に成膜する。

【0036】

図8（c）の工程で残った1個の凹部に成膜用マスクを位置合わせをした後、隔壁上にマスクを載置して3番目（例えば青色）の有機EL媒体8cを所定膜厚に成膜する。このように、1つの開口が1つの第1表示電極上からその隣接する第1表示電極上へ配置されるようにマスクを順次移動せしめる発光層形成工程を順次繰り返す。また、隔壁7があるので、成膜用マスクの位置合わせ、移動載置した蒸着の際に、マスクによる有機EL媒体層を傷つけることがない。

【0037】

図8（d）の第2表示電極形成工程では、RGB3種類の有機EL媒体を所定の個所に成膜した後、成膜用マスクを取り除き、ステップカバレッジのない方法（例えば蒸着等）で、金属蒸気を、基板と略垂直に真上から、3種類の有機EL媒体の各々の上に所定厚に被着させ、第2表示電極の陰極9を形成する。金属蒸気の垂直入射により、隔壁のオーバーハング部7aで陰極9が分断され、その結果、図8（d）のように隔壁両側の陰極9は電氣的に絶縁される。また、金属蒸気が隔壁のオーバーハング部7aを回り込む程度が、有機EL媒体材料粒子流の程度よりも小さくなり、図8（d）のように有機EL媒体8が陰極9からはみ出し、陰極9とITO陽極3とのショートを生じさせない。この電氣的に導通する陰極9の膜厚は、支障のない限り厚く被着させても構わない。陰極の材質は電氣的に導通のあるものならなんでもよいが、Al，Cu，Auなど抵抗率の低い金属が望ましいのはもちろんである。

【0038】

次に、他の実施例である有機ELディスプレイパネル製造方法を説明する。

【0039】

図9（a）に示すように、予めITO陽極3が所定の形状にパターンニングされた基板2上に、逆テーパ断面形状をもった隔壁7を、その上部のオーバーハング部7aが後の金属蒸着における陰極縁部9aを遮るように、形成する。

【0040】

図9（b）に示すように、上記同様に、この基板2に蒸着マスク30を用いて、RGBの有機EL媒体をそれぞれ蒸着する。有機EL媒体の蒸着は基板と蒸着マスクを密着させて行うが、このとき、隔壁がスペーサとなり蒸着マスクとITO上の有機EL媒体の間に隙間ができるので、両者が接触して有機EL媒体に損傷を与えることはない。更に、この蒸着は基板を自公転させたり、複数の蒸発源を用いて他方向から行ったりして、逆テーパ

10

20

30

40

50

一の隔壁の根本付近まで回り込ませる。これは、後に陰極材料を蒸着した際、陰極が有機 E L 媒体層をはみ出して、I T O 陽極とショートするのを防ぐためである。

【0041】

次に、図9(c)に示すように、陰極材料を基板面に対して略垂直な方向から蒸着する。図のように、逆テーパー形状断面隔壁のオーバーハング部7aが陰極縁部9aを遮るため、隔壁の上面と隔壁の根本で陰極が分断され、隣り合った陰極パターンは電氣的に絶縁される。

【0042】

最後に防湿封止を行い、有機 E L フルカラーディスプレイが完成する。

【0043】

図9(b)及び図8(a)～(c)の工程で3色の有機 E L 媒体ではなく1色分の有機 E L 媒体を全面に成膜すれば、単色のディスプレイができるのは明らかである。また、この1色の色を白色にして、R G B のフィルターと組み合わせれば、フルカラーディスプレイにもなる。

【0044】

本発明による有機 E L ディスプレイは、有機 E L 媒体層成膜後に湿式の工程がないため本来の特性を損なうことが無く高効率である。更に、陰極を略垂直方向から成膜するため任意の陰極パターンの形状が可能である。また、逆テーパーの隔壁は通常、フォトリソグラフィの技術を用いて作るため、10 μm 以下の微細なパターンニングが可能である。

【0045】

この発明の特徴は、有機 E L ディスプレイ用基板上に、T 字断面形状または断面形状の1部もしくは全部が逆テーパーであるオーバーハング部を有する隔壁があることと、その逆テーパーの隔壁の根本で、陰極金属材料の粒子流よりも有機 E L 媒体材料の粒子流の方が回り込みが大きいことである。

(実施例1)

化学増幅型レジストを隔壁材料として用い有機 E L ディスプレイパネル製造した場合
ストライプ状に I T O がパターンニングされたガラス基板を十分洗浄し、日本ゼオン製ネガフォトレジスト L A X - 1 を 5 . 6 μm スピンコートした。次に、温風循環式オープンにてプリベークをした後、I T O と直交するストライプ状のフォトマスク（陰極ギャップ 20 μm）を用いて、露光を行った。更に、温風循環式オープンにて P . E . B をしてから現像を行い、幅 20 μm 高さ 5 . 6 μm の隔壁を形成した（図10の図面代用写真参照）。この基板を回転しながら、T P D を 700 オングストローム、A l q₃ を 550 オングストローム蒸着した後、基板の回転を止めて基板面に対して垂直な方向から A l を 1000 オングストローム蒸着した（図11の図面代用写真参照）。図11に示すように隔壁の上面と根本で A l 膜は切れており、隣同士の陰極ラインは完全に絶縁されていた。更に、有機 E L 媒体層のエッジは A l のエッジよりはみ出していたので A l - I T O 間でのショートは起きなかった。

(実施例2)

C₆H₅Cl 処理したレジストを用い有機 E L ディスプレイパネル製造した場合
ストライプ状に I T O がパターンニングされたガラス基板を十分洗浄し、ヘキスト製ポジフォトレジスト A Z 6 1 1 2 を 約 1 μm スピンコートし、温風循環式オープンにてプリベークをした後、32 °C の C₆H₅Cl 溶液中に 30 分浸した。次に、I T O と直交するストライプ状のフォトマスク（陰極ギャップ 2 μm）を用いて露光を行ってから、現像を行って、幅 2 μm 高さ 1 μm の隔壁を形成した（図12の図面代用写真参照）。後は、実施例1と同様の工程で蒸着を行った。その結果、隔壁の上面と根本で A l 膜は切れており隣同士の陰極ラインは完全に絶縁されていた。更に、有機 E L 媒体層のエッジは A l のエッジよりはみ出していたので A l - I T O 間でのショートは起きなかった。

【0046】

この様に本発明によって、隔壁の上部と有機 E L 媒体が成膜された部分との電氣的絶縁が確保され、後にフォトリソグラフィ等の工程を経ずに自動的に陰極のパターンニングが完了

10

20

30

40

50

する。また、隔壁とマスクとを突き合わせて有機EL媒体を成膜することで、有機EL媒体を劣化させる事なく、また隔壁があるため隣接した画素に成膜された有機EL媒体が回り込まずに微細な領域に塗り分けることが可能となり、高精彩なフルカラーディスプレイが実現できる。

(実施例3)

他に微細なピッチのディスプレイを実現するものとして、図13に示すように、第2表示電極に接続された非線形素子（たとえば薄膜トランジスタ（TFT）、コンデンサなど）が、データ信号ライン及び走査信号ラインとともに基板平面上に形成したフルカラーディスプレイがある。図示するように、上記実施例と同様にITO膜3、有機EL媒体層8及び第2表示電極9を成膜した前面ガラス基板2を形成し、そして、この前面基板とは別に所定の画素数だけ第2表示電極と接続すべきTFTなどの非線形素子101を作り込んである裏面用ガラス基板102を形成し、両基板を非線形素子101が対応する第2表示電極9だけと電気的に導通するように異方導電性接着剤103にて張り合わせてディスプレイとする。

10

【0047】

この方法でディスプレイを作製する際は、画素ひとつひとつに独立した陰極が有機EL媒体の上部に成膜されしかも他の画素の陰極とは絶縁されていなければならない。この条件を実現するためには、上記したようなT字型の隔壁を2次元マトリクス状に作製して解決出来る。

【0048】

20

さらに、本発明は、第1及び第2表示電極並びに有機EL層の絶縁破壊の問題を解決し、素子の特性を劣化することなく発光機能層や第2電極を自由な形状にパターンニングしたディスプレイを歩留まり良く生産できる素子及びその方法をも提供する。すなわち、実施例4として隔壁のオーバーハング部下の第1及び第2表示電極間に絶縁膜を追加する方法及び素子と、実施例5として隔壁及び第2表示電極上に絶縁封止膜を追加する方法及び素子と、を本発明は実現する。

(実施例4) 絶縁膜の追加

第2表示電極第1及び第2表示電極のショート、特に第2表示電極エッジ部の短絡を防止する。

【0049】

30

図14(a)に示すように、予め第1表示電極3（ITO陽極）が所定の形状にパターンニングされた基板上に、少なくとも後に蒸着する第2表示電極パターンのエッジにあたる部分に絶縁膜40を形成する。

【0050】

次に、図14(b)に示すように、逆テーパ断面形状をもった隔壁7を、その上部のオーバーハング部7aが後の金属蒸着における第2表示電極の縁部、すなわち絶縁膜40を遮るように、形成する。絶縁膜40は第2表示電極パターンのギャップにあたる部分に形成される。

【0051】

次に、図14(c)に示すように、この基板2に蒸着マスク30を用いて、RGBの有機材料を上記同様に、それぞれ蒸着する。この基板に蒸着マスク30を用いて、R、G及びBの有機EL媒体をそれぞれ蒸着する。有機EL媒体の蒸着は基板と蒸着マスクを密着させて行うが、このとき、隔壁7がスペーサとなり蒸着マスクと第1表示電極上の有機EL媒体の間に隙間ができるので、両者が接触して有機EL媒体に損傷を与えることはない。

40

【0052】

次に、図14(d)に示すように、更に、少なくとも基板の表示領域を覆うような全面に第2表示電極材料を蒸着する。この第2表示電極材料の蒸着は、基板からの法線からの逆テーパ隔壁のテーパ角度 θ' より小さい角度 θ ($\theta < \theta'$)で行う。例えば、図のように、陰極材料を基板面に対して略垂直な方向から蒸着する。隔壁の断面が逆テーパ形

50

状すなわちオーバーハング部のため、隔壁の上面と隔壁の根本で第2表示電極が分断され、隣り合った第2表示電極パターンは電氣的に絶縁される。また、第2表示電極のエッジが有機膜のエッジをオーバーラップしても、図14(a)の工程で形成した絶縁膜7により第2表示電極と第1表示電極とが絶縁されるため両者はショートしない。

【0053】

最後に、防湿のための封止を行い、有機ELフルカラーディスプレイが完成する。

【0054】

図14(c)の工程で3色ではなく1色分の材料を全面に成膜すれば、単色のディスプレイができるのは明らかである。また、この1色の色を白色にして、RGBのフィルターと組み合わせれば、フルカラーディスプレイになる。

10

【0055】

図14(a)の工程で形成した絶縁膜の形成範囲は、少なくとも隔壁によって分断された第2表示電極のエッジ部、最大で表示ドット(セグメント)を除く基板全面である。例えば、この絶縁膜形成工程における基板の平面図で示せば、絶縁膜は、図15に示すように、第1表示電極3に垂直に伸長する平行な一対の絶縁膜ストライプ40a, 40bであって、図16に示すように、後に形成される隔壁7の根本を挟むように形成される。また、図17に示すように、絶縁膜を、図15に示す一対のストライプを1つにまとめて、図18に示すように、その中心線上で隔壁7が伸長できるようなストライプとすることもできる。さらにまた、図19に示すように、絶縁膜を第1表示電極伸長方向に連結させて、画素すなわち第1表示電極の露出部分50を除く全面に且つ、第1表示電極のエッジ60を覆うように形成すれば、第1表示電極エッジと第2表示電極のショートをも防止できる。

20

【0056】

本発明による有機ELディスプレイは、発光機能層成膜後に湿式の工程がないため本来の特性を損なうことが無く高効率であり、第2表示電極の蒸着方向に自由度があるため、任意の第2表示電極パターンの形状が可能である。また、第2表示電極エッジ部及び第1表示電極間に絶縁膜が挿入されているため、この部分でのショートが起きない。更に、絶縁膜や逆テーパの隔壁は通常、フォトリソグラフィの技術を用いて作るため、10 μ m以下の微細なパターニングが可能である。

【0057】

具体的に、上記実施例1におけると同様の第1表示電極及び隔壁形成工程間に絶縁膜を形成する工程を挿入して有機ELディスプレイを作製した。

30

【0058】

例えば、第1表示電極としてITOがストライプ状にパターニングされたガラス基板を十分洗浄し、絶縁膜として東京応化製フォトレジストOFPR-8000を約1 μ mスピコート、温風循環式オープンにてプリベーク、ITOと直交するストライプ状のフォトマスク(ライン幅20 μ m)を用いて露光、現像、リンスの後、温風循環式オープンにてポストベークを行った。図17に示すストライプ絶縁膜40を形成した。次に、日本ゼオン製ネガフォトレジストLAX-1を5.6 μ mスピコートし、温風循環式オープンにてプリベークをした後、先に形成した絶縁膜のパターンと中心線が一致するようなストライプ状のフォトマスク(ライン幅18 μ m)を用いて露光を行った。更に、温風循環式オープンにてP.E.Bをしてから現像を行い、幅20 μ m高さ5.6 μ mの逆テーパ隔壁を形成した。この逆テーパ隔壁のテーパ角度 θ' を測定したところ約30度であった。

40

【0059】

次に、図20のような位置関係、すなわち、基板2を蒸着装置の真空処理室内のターンテーブルに取付け、この室内を -5×10^{-6} torrまでに排気し、基板の第1表示電極形成面の1つの法線に対して自転するように回転させながら、抵抗加熱により、発光機能層としてTPDを700Å膜厚で、Alq₃を550Å膜厚で、第2表示電極としてAlを1000Å膜厚で蒸着した。基板2の回転中心線上に種々の材料の蒸発源55を配置し

50

て、蒸着は、蒸発源から回転基板縁部までの円錐母線と基板法線とのなす角度 $\theta = 20$ 度で逆テーパ隔壁のテーパ角度 $\theta' = 30$ 度より小さい角度で行った。できあがった素子について隣り合うA1ライン同士の導通を調べたところ、完全に絶縁されていた。また、この素子のITO-A1間に10Vの電圧を印加したところ、選択された部分が明るく緑色に発光しITO-A1間でのショートは起きなかった。

（実施例5）封止膜の追加

実施例4の絶縁膜の追加と封止効果を高めるため、封止膜を逆テーパ隔壁の裏側に回り込ませ、第2表示電極パターンを完全に被覆する。実施例4同様に図14(a)～(d)に示す工程で第2表示電極を成膜した基板に、防湿効果の高い絶縁性封止膜45を、基板を自公転させた蒸着、スパッタ、CVD方法など回り込みの良い方法で成膜する。

10

【0060】

この封止膜は、図21に示すように、逆テーパ隔壁7の裏側に良く回り込んで付着するので、図22に示すように、絶縁膜40に達して第2表示電極ライン9を完全に覆う形状になる。さらに封止膜45は、図23に示すように、絶縁膜40の逆テーパ側壁をも覆うように、第2表示電極ラインを完全に覆えばどんな形状でもかまわない。

【0061】

また、この封止構造は、実施例4の絶縁膜がない上記実施例の場合にも応用でき、図24に示すように、封止膜材料を逆テーパ隔壁7の裏側に良く回り込ませ第1表示電極及び基板上に付着させたり、図25に示すように、逆テーパ側壁をも覆うようにして第2表示電極ライン9を完全に覆うこともできる。

20

【0062】

本発明による有機ELディスプレイは、実施例4と同様の効果があるほか、封止膜が第2表示電極パターンを完全に覆うため第2表示電極エッジからの非発光部の進行を防止できる。すなわち耐久性が非常に高い。

【0063】

具体的に、上記実施例4の第2表示電極形成工程の後に封止膜を追加して有機ELディスプレイを作製した。

【0064】

実施例4と同様の工程でA1の蒸着まで行い素子を作製した後、更にスパッタ法により SiO_2 を1 μm 成膜した。こうして作製した素子について隣り合うA1ライン同士の導通を調べたところ、完全に絶縁されていた。また、この素子のITO-A1間に10Vの電圧を印加したところ、選択された部分が明るく緑色に発光しITO-A1間でのショートは起きなかった。更に、この素子を大気中に放置したところ、A1エッジからの非発光部の拡大が抑えられた。

30

【図面の簡単な説明】

【0065】

【図1】本発明による有機ELディスプレイパネルの概略部分拡大平面図。

【図2】本発明による有機ELディスプレイパネルの概略部分斜視図。

【図3】本発明による有機ELディスプレイパネルの概略部分断面図。

【図4】本発明による実施例の有機ELディスプレイパネルの基板の概略斜視図。

40

【図5】本発明による実施例の有機ELディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分断面図。

【図6】本発明による実施例の有機ELディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分拡大断面図。

【図7】本発明による実施例の有機ELディスプレイパネルにおける隔壁の概略部分拡大断面図。

【図8】本発明による実施例の有機ELディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分断面図。

【図9】本発明による他の実施例の有機ELディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分断面図。

50

【図 1 0】本発明による実施例 1 の有機 E L ディスプレイパネルにおける隔壁を撮影した図面代用顕微鏡 (S E M) 写真。

【図 1 1】本発明による実施例 1 の有機 E L ディスプレイパネルにおける隔壁付近を撮影した図面代用顕微鏡 (S E M) 写真。

【図 1 2】本発明による実施例 2 の有機 E L ディスプレイパネルにおける隔壁を撮影した図面代用顕微鏡 (S E M) 写真。

【図 1 3】本発明による実施例 3 の有機 E L ディスプレイパネルの概略部分断面図。

【図 1 4】本発明による実施例 4 の有機 E L ディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分断面図。

【図 1 5】本発明による実施例 4 の有機 E L ディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分平面図。 10

【図 1 6】図 1 5 の線 A A に沿った断面図。

【図 1 7】本発明による実施例 4 の有機 E L ディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分平面図。

【図 1 8】図 1 7 の線 A A に沿った断面図。

【図 1 9】本発明による実施例 4 の有機 E L ディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分平面図。

【図 2 0】本発明による実施例 4 の有機 E L ディスプレイパネル製造工程における蒸着装置内の基板及び蒸着源の概略図。

【図 2 1】本発明による実施例 5 の有機 E L ディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分断面図。 20

【図 2 2】本発明による実施例 5 の有機 E L ディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分断面図。

【図 2 3】本発明による実施例 5 の有機 E L ディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分断面図。

【図 2 4】本発明による実施例 5 の有機 E L ディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分断面図。

【図 2 5】本発明による実施例 5 の有機 E L ディスプレイパネル製造工程における基板の概略部分断面図。

【符号の説明】 30

【 0 0 6 6 】

1 発光画素

2 基板

3 第 1 表示電極ライン

5 非線形素子

7 隔壁

7 a オーバーハング部

8 有機 E L 媒体

9 第 2 表示電極ライン

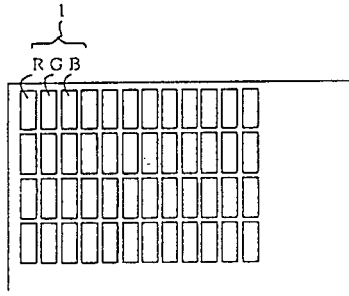
1 0 保護膜

4 0 絶縁膜

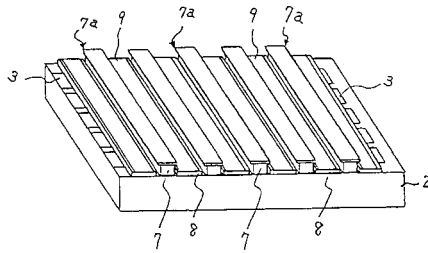
4 5 封止膜

40

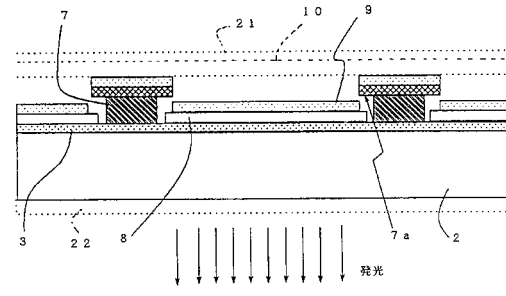
【図 1】



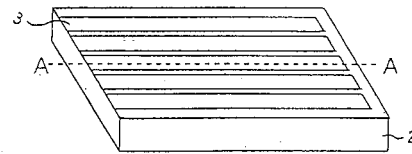
【図 2】



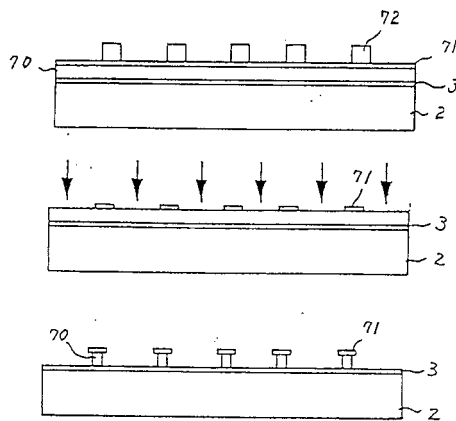
【図 3】



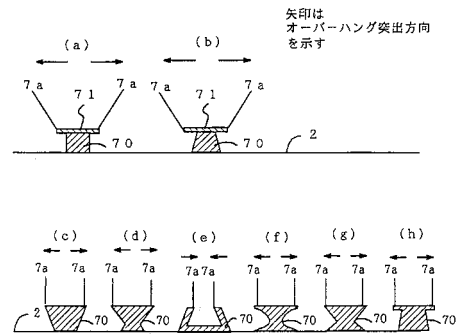
【図 4】



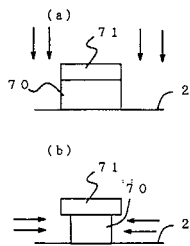
【図 5】



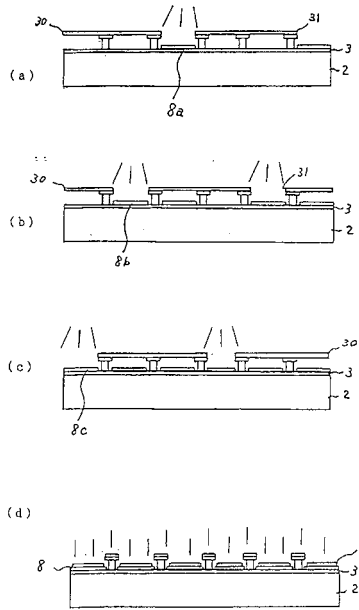
【図 7】



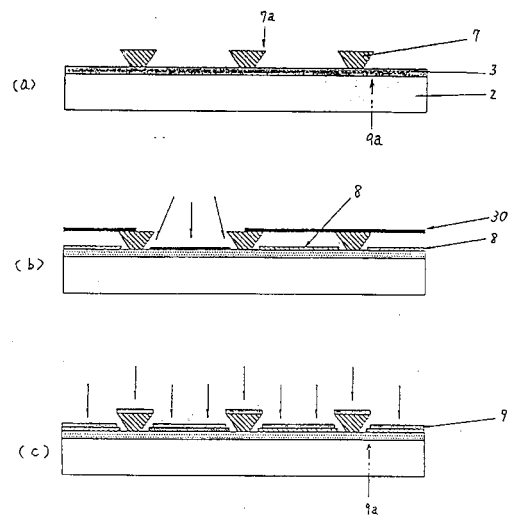
【図 6】



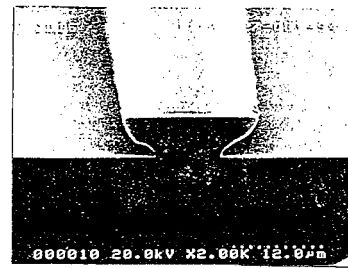
【図 8】



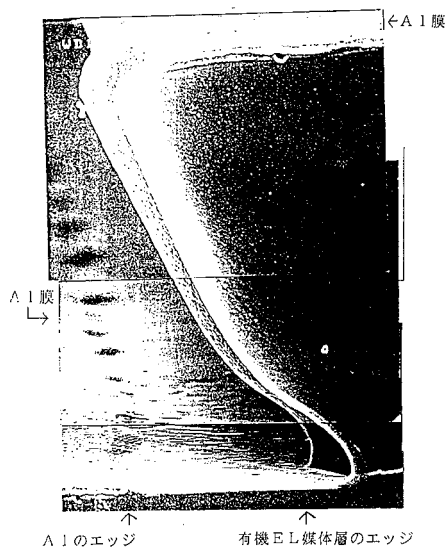
【図 9】



【図 10】



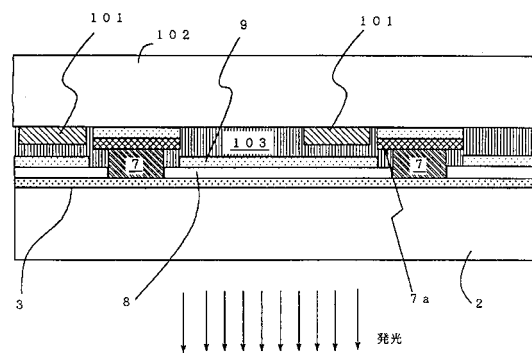
【図 11】



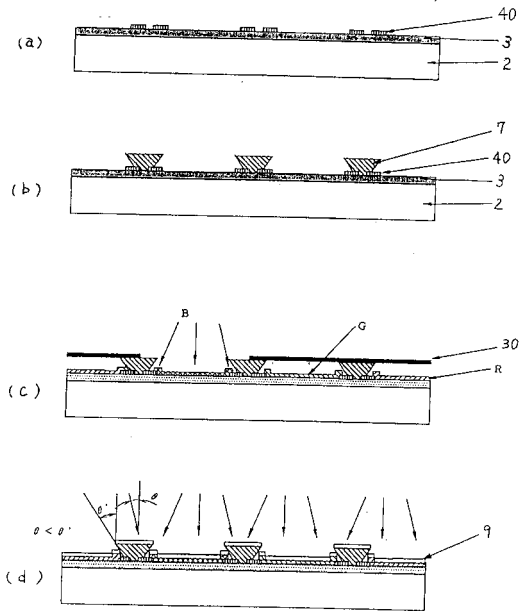
【図 12】



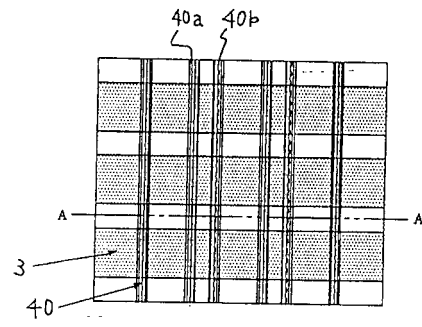
【図 13】



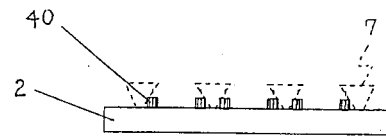
【図 14】



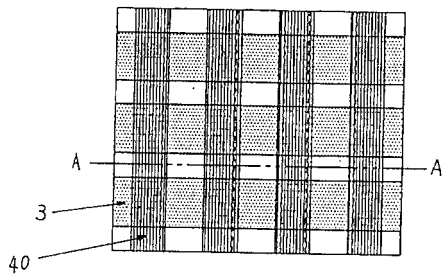
【図 15】



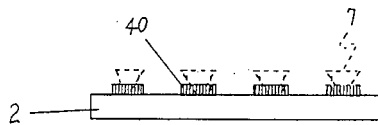
【図 16】



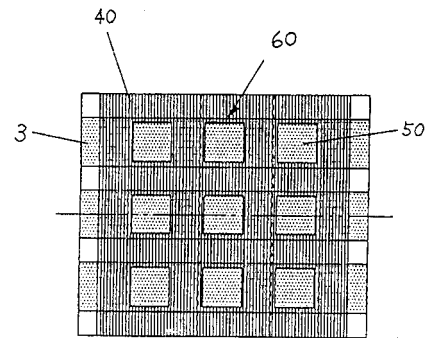
【図 17】



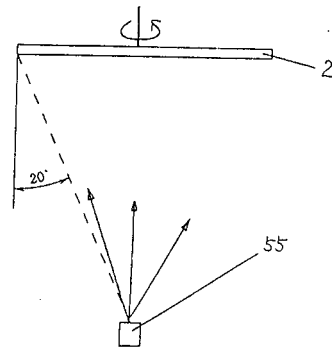
【図 18】



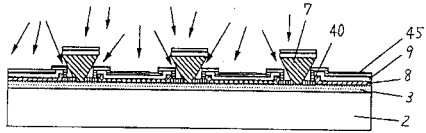
【図 19】



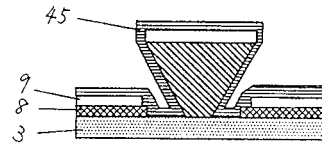
【図 20】



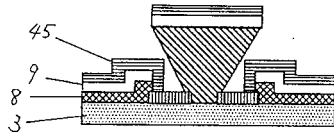
【図 2 1】



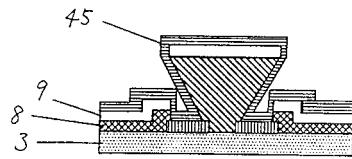
【図 2 5】



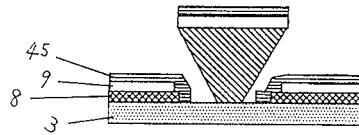
【図 2 2】



【図 2 3】



【図 2 4】



フロントページの続き

- (56)参考文献 特開平05-275172 (JP, A)
特開平05-258859 (JP, A)
特開昭59-111325 (JP, A)
特開平05-109712 (JP, A)
特開平05-281703 (JP, A)
特開平06-104256 (JP, A)
特開平07-029846 (JP, A)
特開平08-315981 (JP, A)
特許第3568890 (JP, B2)
特許第3813217 (JP, B2)
特許第3901675 (JP, B2)
特許第3901699 (JP, B2)
特許第3901719 (JP, B2)
特許第3926314 (JP, B2)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 27/32
H01L 51/50-51/56
H05B 33/00-33/28

专利名称(译)	有机电致发光显示板		
公开(公告)号	JP4060876B2	公开(公告)日	2008-03-12
申请号	JP2006278761	申请日	2006-10-12
[标]申请(专利权)人(译)	日本先锋公司		
申请(专利权)人(译)	先锋公司		
当前申请(专利权)人(译)	先锋公司		
[标]发明人	永山健一 宫口敏		
发明人	永山 健一 宫口 敏		
IPC分类号	H05B33/22 H05B33/12 H01L51/50 G09F9/30 H01L27/32		
FI分类号	H05B33/22.Z H05B33/12.B H05B33/14.A G09F9/30.365.Z G09F9/30.365 H01L27/32 H05B33/04 H05B33/24 H05B33/26.Z		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC21 3K107/CC45 3K107/DD02 3K107/DD03 3K107/DD22 3K107/DD27 3K107/DD89 3K107/DD91 3K107/EE02 3K107/EE33 3K107/EE46 5C094/AA31 5C094/AA43 5C094/BA27 5C094/DA07 5C094/EA05 5C094/ED11		
代理人(译)	藤村元彦		
审查员(译)	福田 聪		
优先权	1995053011 1995-03-13 JP		
其他公开文献	JP2007042658A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种显示面板，其能够以自由形状图案化有机EL介质层和负电极而不会劣化元件的特性。ŽSOLUTION：显示面板包括形成在基板上的第一显示电极；绝缘膜，形成在第一显示电极上，并具有对应于多个发光部分的开口；阻挡肋形成在绝缘膜上；在覆盖开口的同时形成有机电致发光介质的薄膜；第二显示电极，其中在有机电致发光介质的薄膜上的阻挡肋的两侧的绝缘膜上形成边缘。Ž

【图2】

